

【施設共用募集対象装置の設備仕様】

No.	設備・装置の種類	装置の概要・条件	担当者・連絡先	備考
1	J-KARENレーザー装置	<p>高出力・超短パルスレーザー</p> <p>1) パワーアンプモード 中心波長：810nm パルスエネルギー：1J パルス幅：30fs 繰り返し：10Hz（最大） （1Hz、シングルショットも可能）</p> <p>2) ブースターアンプモード 中心波長：810nm パルスエネルギー：～30J（最大） パルス幅：～30fs（半値全幅） 繰り返し：10秒/shot（最大） （シングルショットも可能）</p>	金沢 修平 TEL: 0774-71-3385	(木津) 実験棟 C103号室
2	X線レーザー実験装置	<p>プラズマ軟X線レーザー</p> <p>波長：13.9nmのみ パルスエネルギー：～1μJ パルス幅：約10ps 繰り返し：0.1Hz（最大）</p>	長谷川 登 TEL: 0774-71-3345	(木津) 実験棟 C104号室
3	kHzチタンサファイアレーザー	<p>高繰り返しレーザー</p> <p>波長：800nm パルスエネルギー：1mJ パルス幅：60fs 繰り返し：1kHz</p>	板倉 隆二 TEL: 0774-71-3489	(木津) 実験棟 C102号室
4	X線回折装置	<p>X線回折装置（リガク：SLX2000）</p> <p>1) ターゲット：Cu （真空封止型（最大3kW））</p> <p>2) 高精度ゴニオメータ搭載</p> <p>3) 小角X線散乱測定による多層膜等の薄膜評価</p> <p>4) 各種解析ソフト搭載（GXRR等）</p> <p>成膜装置（㈱大阪真空）</p> <p>1) ターゲット数：4元(5インチ角)</p> <p>2) 成膜プロセス：シーケンサによる自動成膜（手動も可）</p> <p>3) 膜厚制御法：シャッターによる時間制御（分解能0.1s）</p> <p>4) 基板：φ50mm×12mm（最大）、2個、自公転式</p>	今園 孝志 TEL: 0774-71-3372	(木津) 実験棟 C128号室
5	軟X線平面結像型回折格子評価装置	<p>電子衝突型軟X線源による平面結像型回折格子の評価装置</p> <p>1) 回折格子の溝本数：1200、2400本/mm</p> <p>2) 光源：B、C、Mg、Al、Si、Pt、W等の特性X線</p> <p>3) 検出器：CCD</p>	今園 孝志 TEL: 0774-71-3372	(木津) 実験棟 C127号室
6	QUADRA-Tレーザーシステム	<p>QUADRA-Tレーザーシステム</p> <p>波長：1030nm パルスエネルギー：10mJ パルス幅：1ps 繰り返し：1kHz</p>	圓山 桃子 TEL: 0774-71-3344	(木津) 実験棟 C102号室